

2024年3月期 第2四半期

# 決算説明資料

---

上村工業株式会社

東京証券取引所スタンダード市場 証券コード：4966

2023年11月13日

2023年11月24日更新

# 2024年3月期 第2四半期 決算概要

## 【連結会計期間】

日本国内(2社)：4月～9月／海外(10社)：1月～6月

### ● 表面処理用資材事業

- ・ 主力のパッケージ基板向けのめっき薬品は、前年後半から続いているデータセンター向けサーバー市場における投資抑制とパソコンやスマートフォンの販売台数の落ち込みによる在庫調整の影響を受けて、売上高、セグメント利益ともに前年同四半期を下回った。

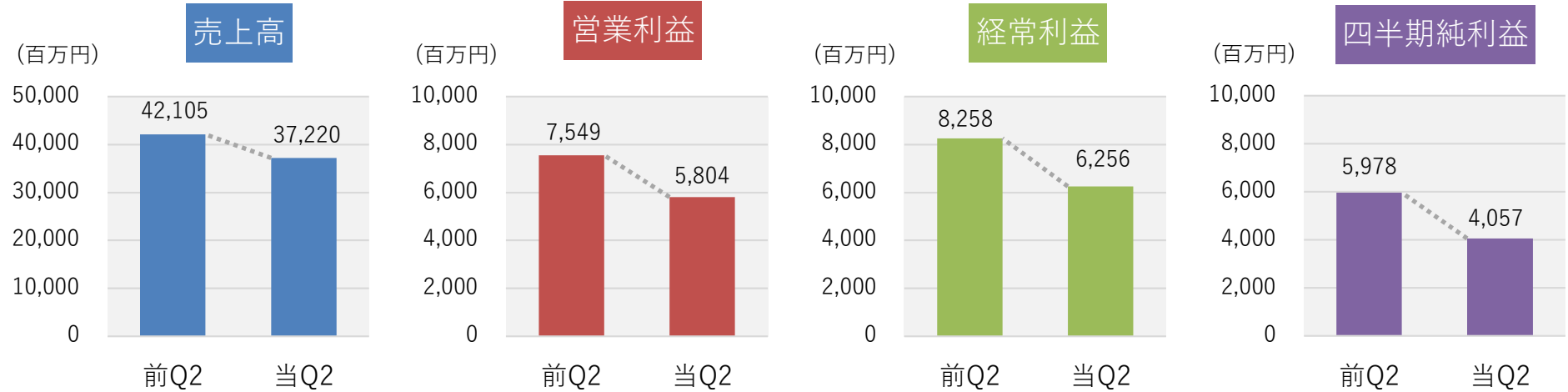
### ● 表面処理用機械事業

- ・ 日本、中国市場において半導体や電子部品向けのめっき用装置の販売が増加し、売上高、セグメント利益ともに前年同四半期を上回った。

### ● めっき加工事業

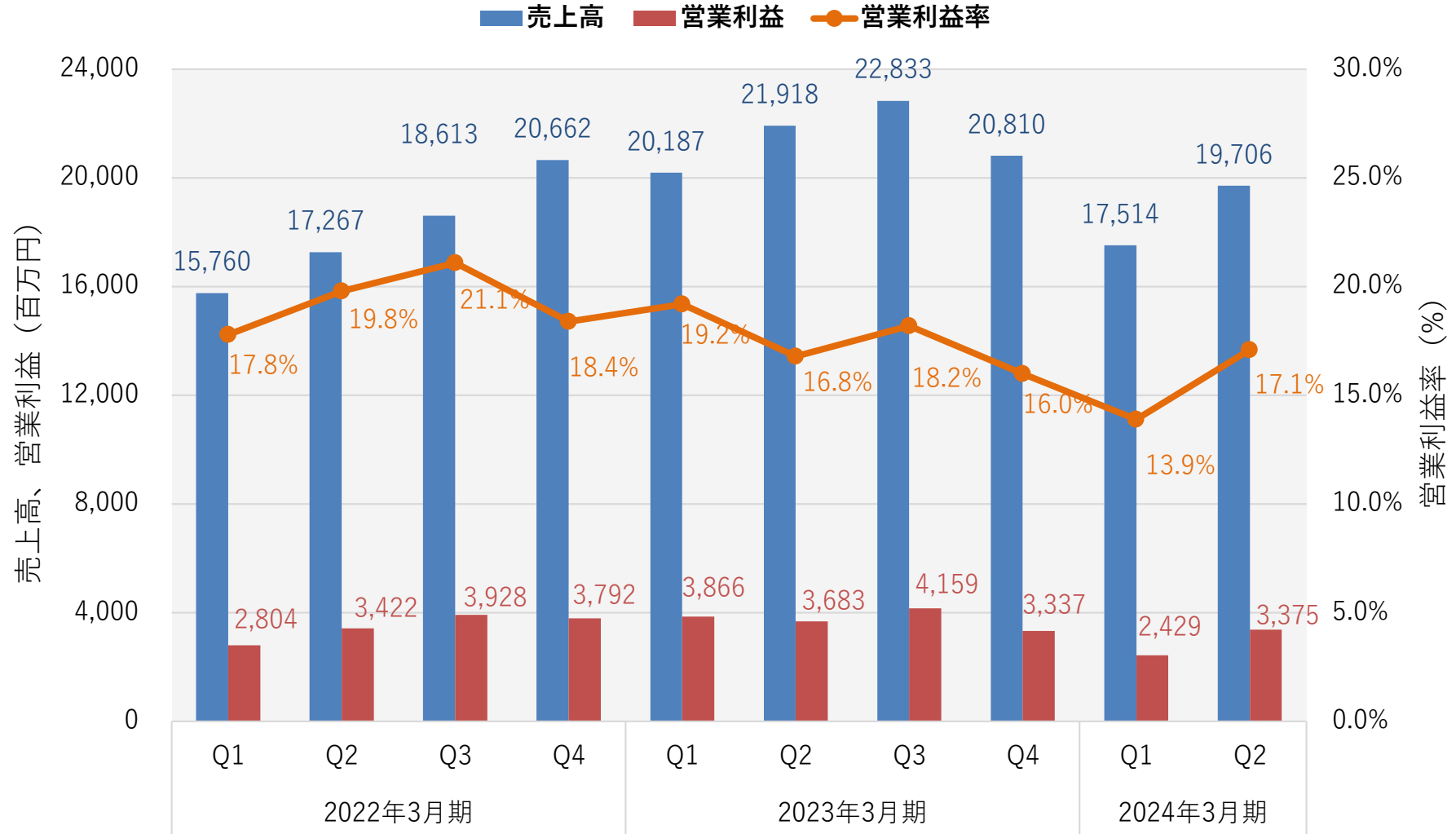
- ・ タイやインドネシアにおける自動車産業は、急速な電気自動車の普及や塗装された部品の採用拡大により、プラスチックへのめっき加工の需要が低迷し、売上高は前年同四半期を下回り、セグメント損失となった。

# 2024年3月期 第2四半期 決算概要



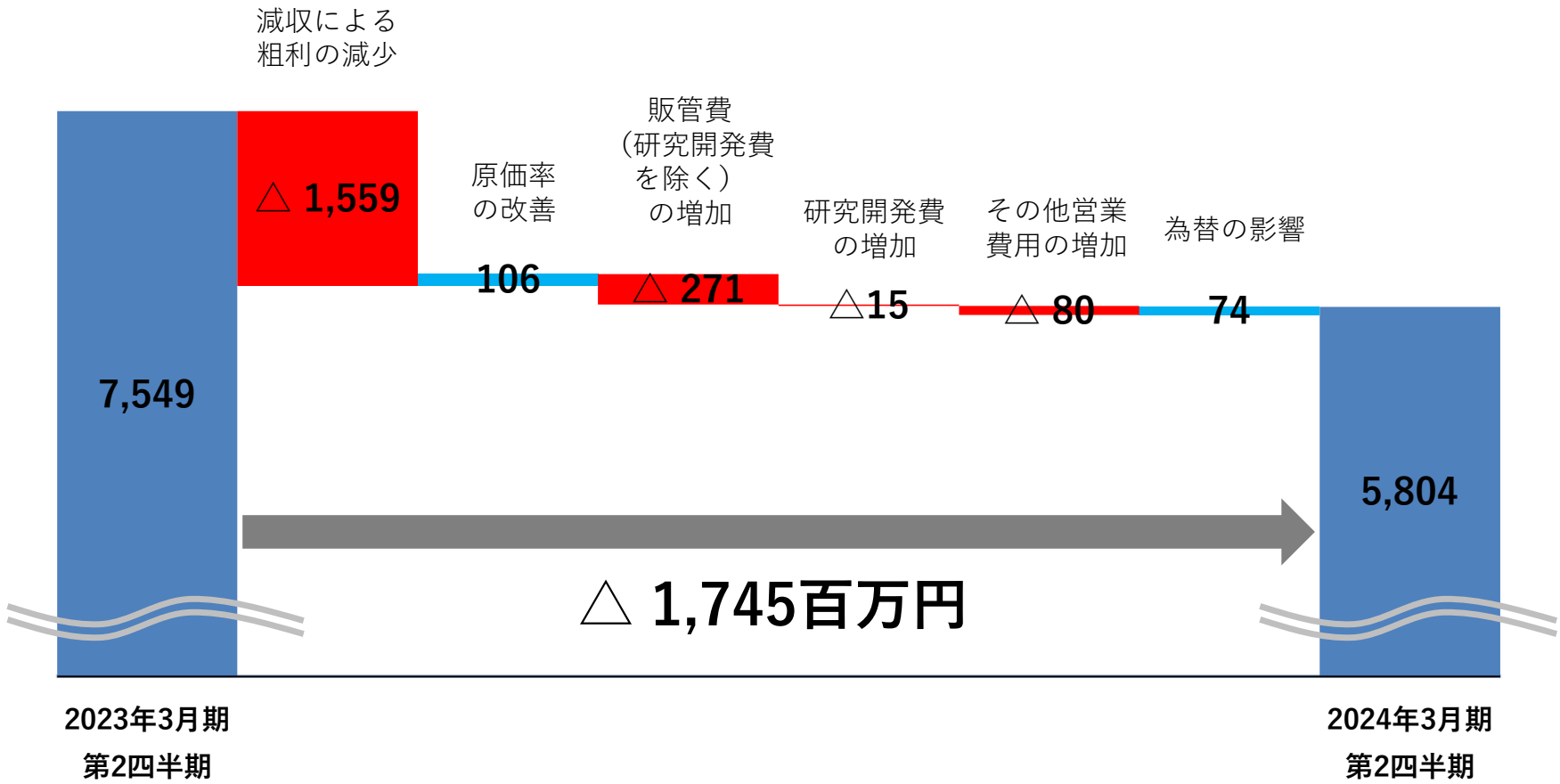
(単位：百万円)	前第2四半期 累計実績	当第2四半期 累計予想	当第2四半期 累計実績	前期比	予想比
売上高	42,105	27,290	37,220	△ 4,885 (△ 11.6%)	+ 9,930 (+ 36.4%)
営業利益	7,549	4,000	5,804	△ 1,745 (△ 23.1%)	+ 1,804 (+ 45.1%)
経常利益	8,258	4,130	6,256	△ 2,002 (△ 24.2%)	+ 2,126 (+ 51.5%)
四半期純利益	5,978	3,070	4,057	△ 1,921 (△ 32.1%)	+ 987 (+ 32.1%)
為替：米ドル	123.14円	133.53円	135.00円	11.86円安	1.47円安

# 四半期毎の業績推移

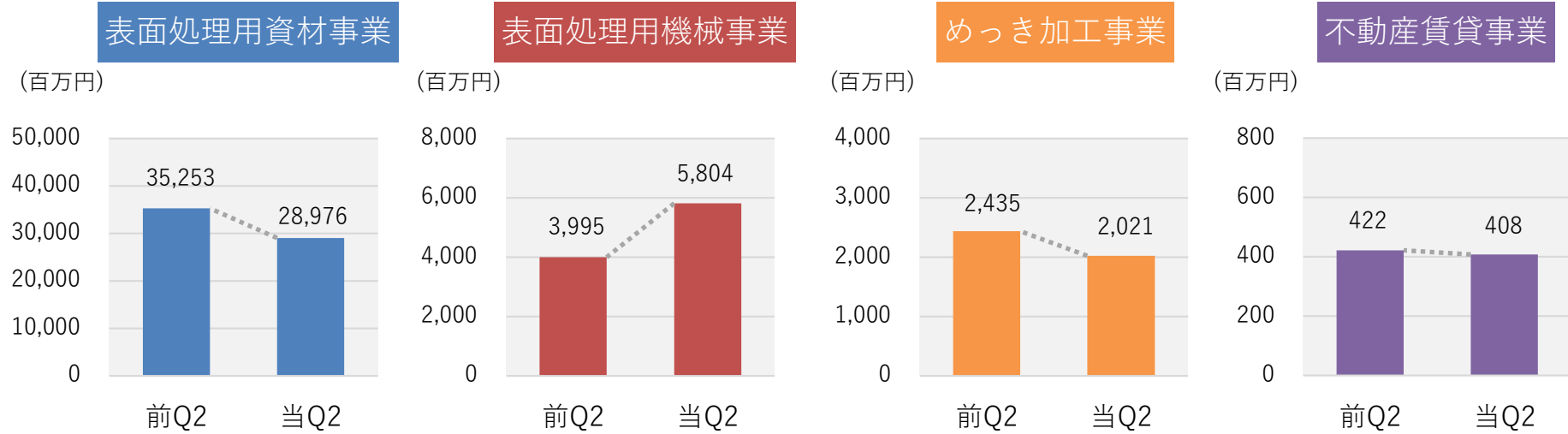


# 営業利益の増減要因

(単位：百万円)



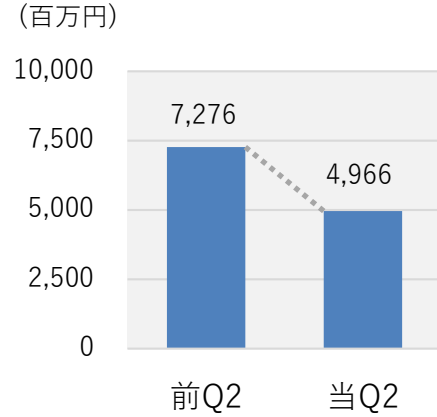
# 事業セグメント別売上高



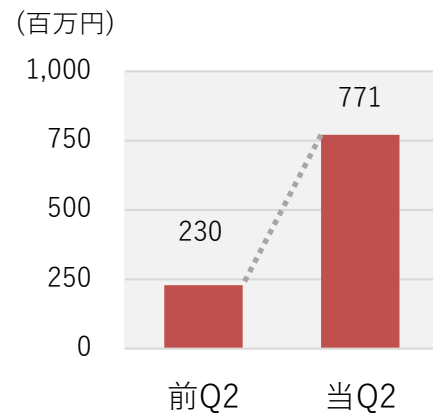
(単位：百万円)	前第2四半期 累計実績	当第2四半期 累計実績	増減額	増減率
表面処理用資材	35,253	28,976	△ 6,276	△ 17.8%
表面処理用機械	3,995	5,804	+ 1,809	+ 45.3%
めっき加工	2,435	2,021	△ 413	△ 17.0%
不動産賃貸	422	408	△ 14	△ 3.4%

# 事業セグメント別営業利益

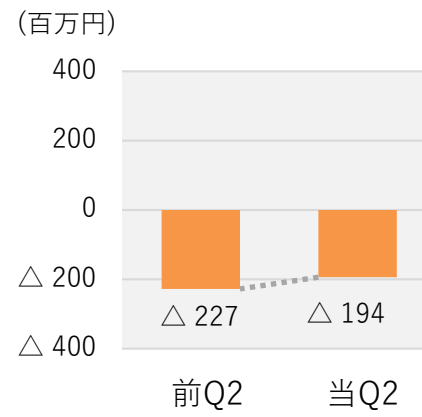
表面処理用資材事業



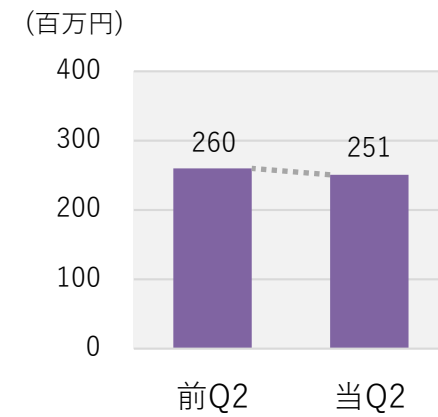
表面処理用機械事業



めっき加工事業

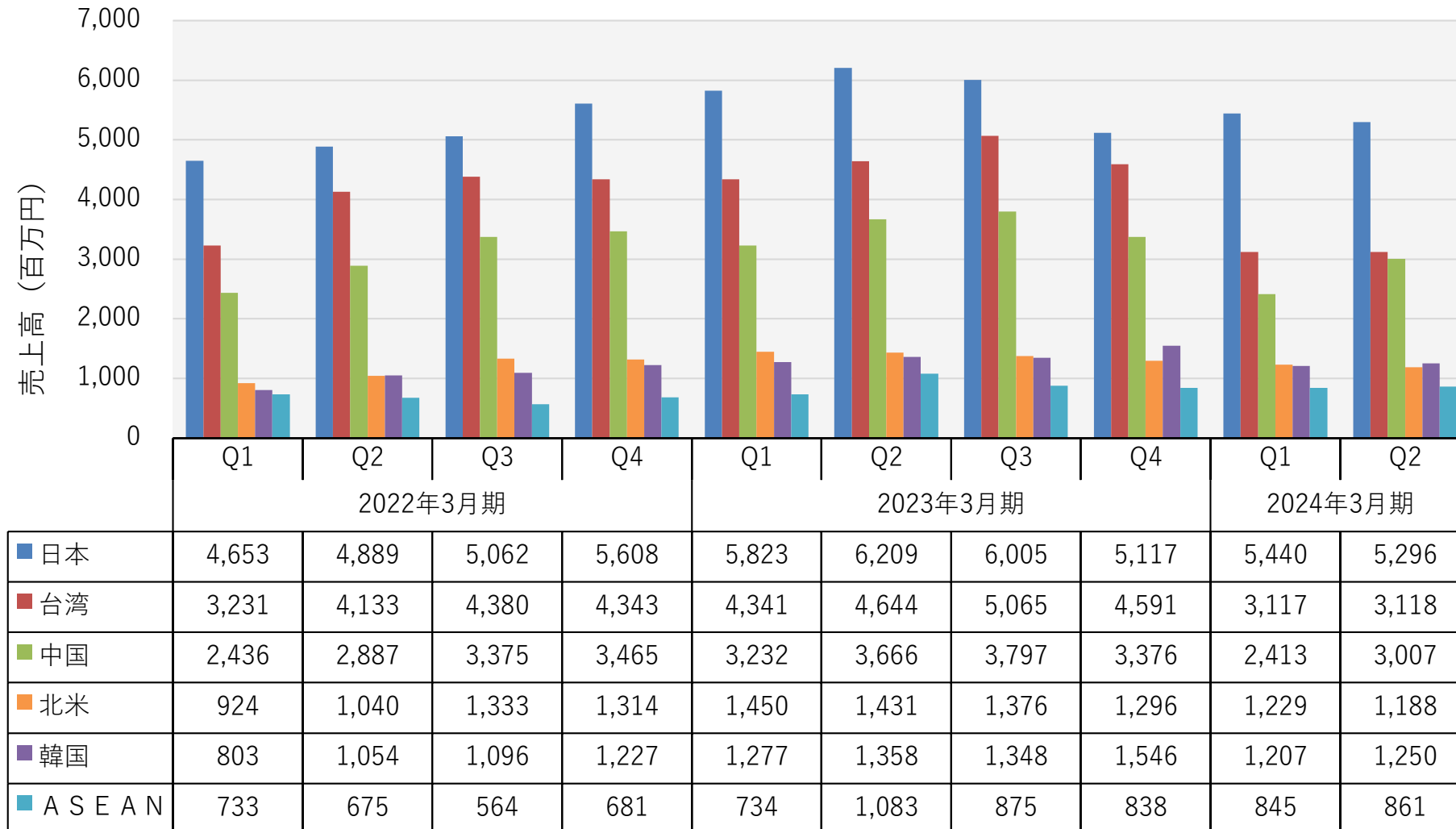


不動産賃貸事業



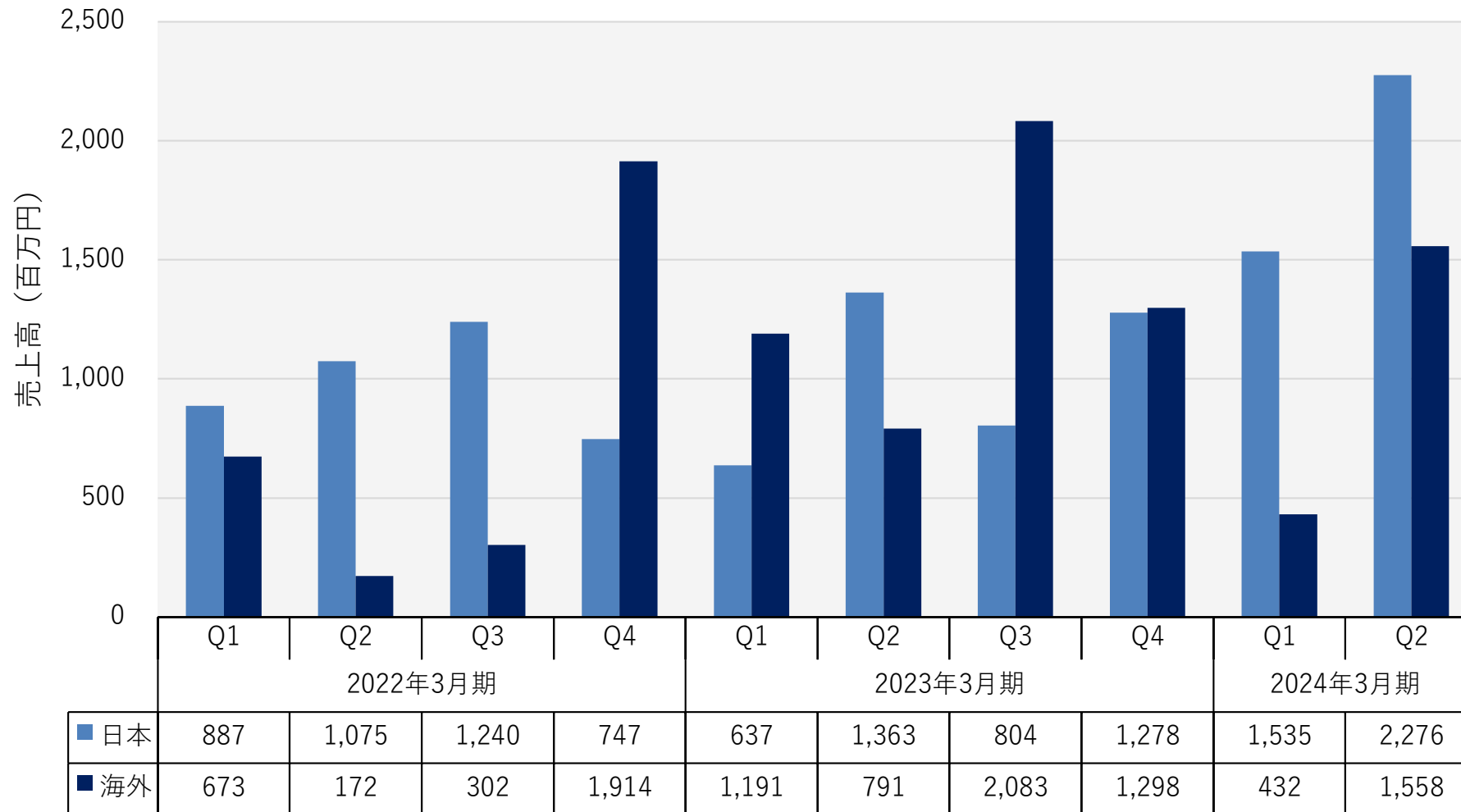
(単位：百万円)	前第2四半期 累計実績	当第2四半期 累計実績	増減額	増減率
表面処理用資材	7,276	4,966	△ 2,310	△ 31.7%
表面処理用機械	230	771	+ 541	+ 235.0%
めっき加工	△ 227	△ 194	+ 33	-
不動産賃貸	260	251	△ 8	△ 3.4%

# 表面处理用資材事業 売上高推移

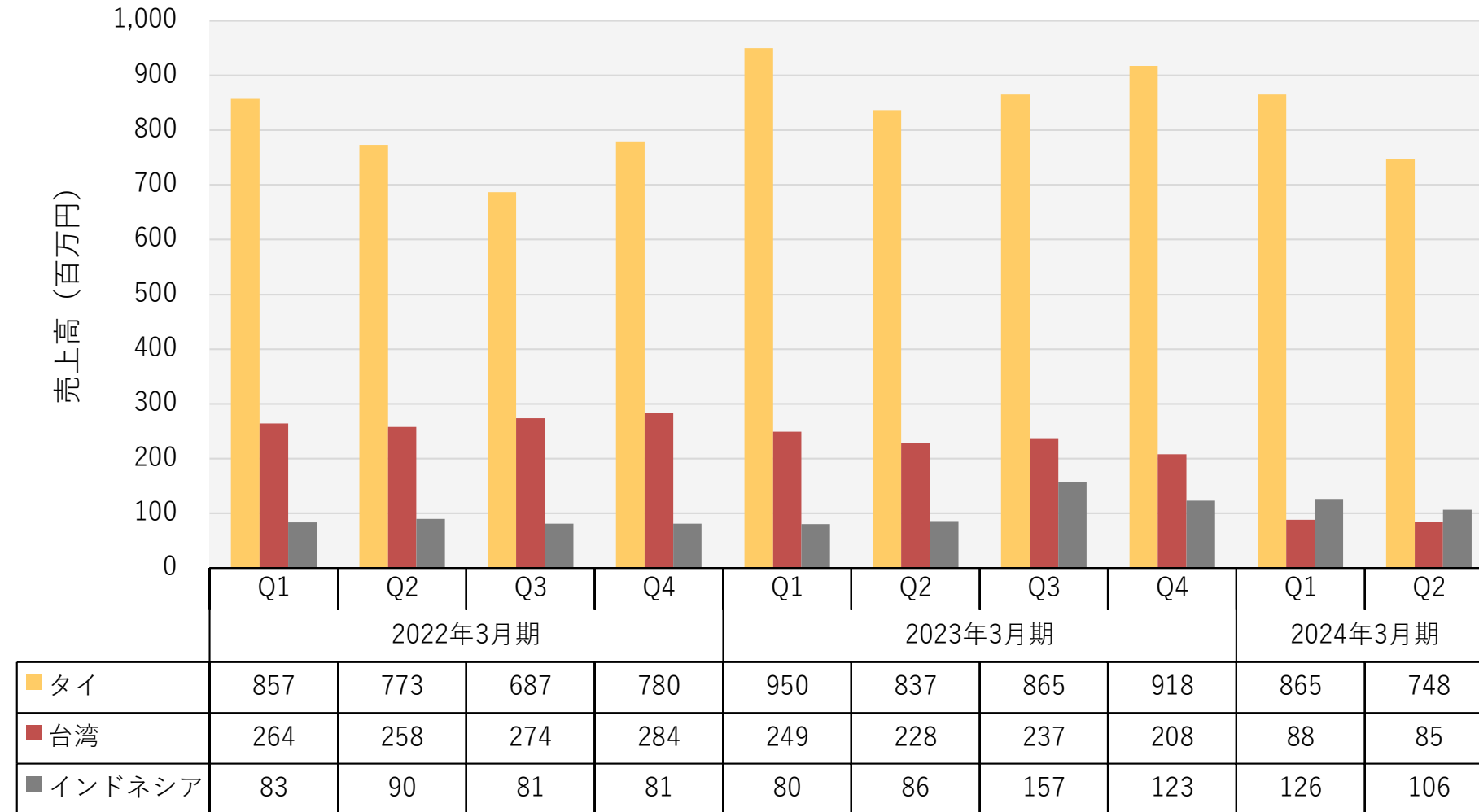




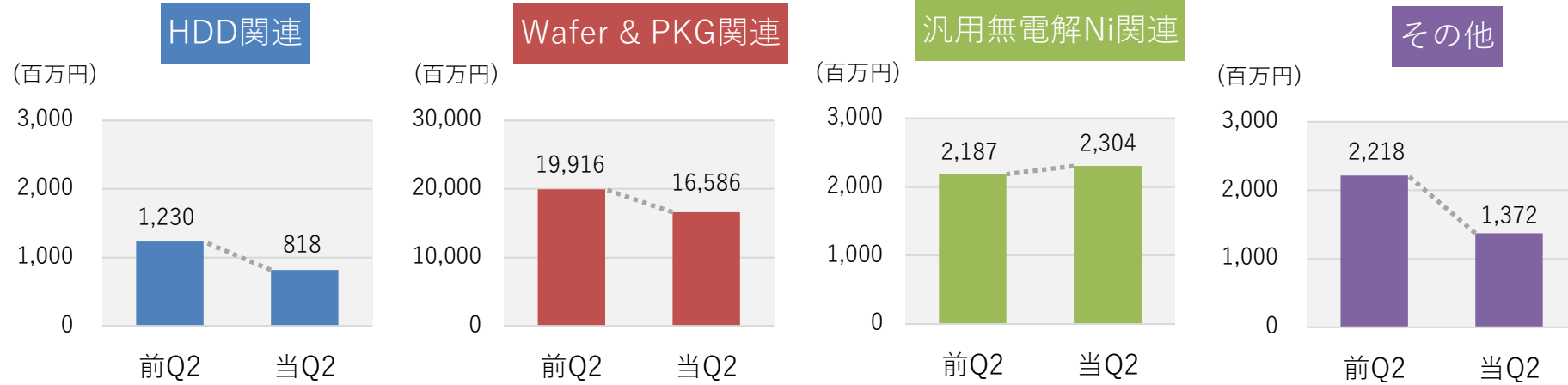
# 表面処理用機械事業 売上高推移



# めっき加工事業 売上高推移



# 薬品カテゴリー別売上高



(単位：百万円)	前第2四半期累計実績		当第2四半期累計実績		増減額	増減率
		構成比		構成比		
HDD関連	1,230	4.8%	818	3.9%	△ 412	△ 33.5%
Wafer & PKG関連	19,916	77.9%	16,586	78.7%	△ 3,330	△ 16.7%
汎用無電解Ni関連	2,187	8.6%	2,304	10.9%	+ 116	+ 5.3%
薬品その他	2,218	8.7%	1,372	6.5%	△ 846	△ 38.1%
合計	25,554	100.0%	21,082	100.0%	△ 4,472	△ 17.5%

薬品の売上高は、表面処理用資材事業に含まれます。薬品には研磨剤、工業薬品、金属等は含んでおりません。※内部売上高含む

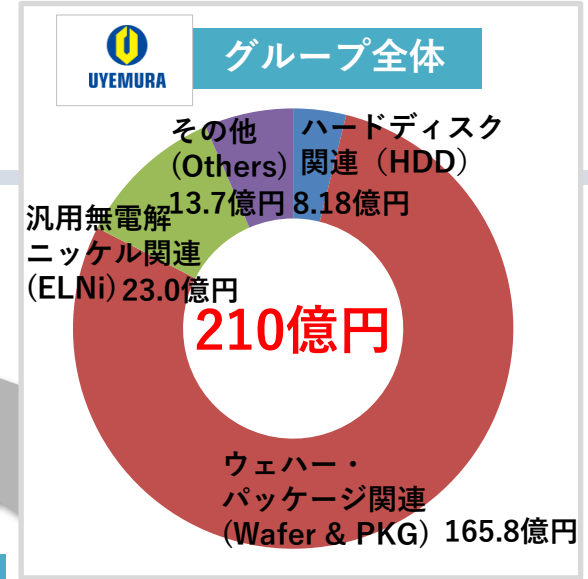
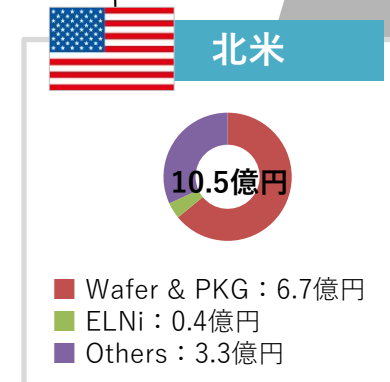
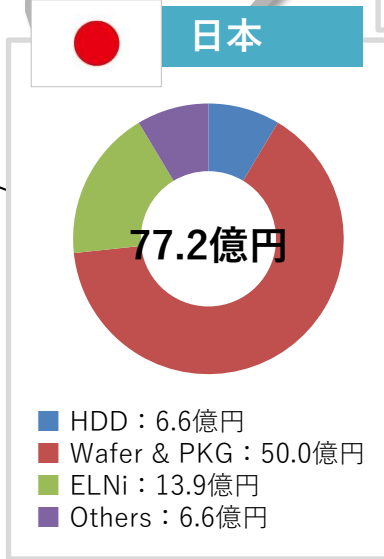
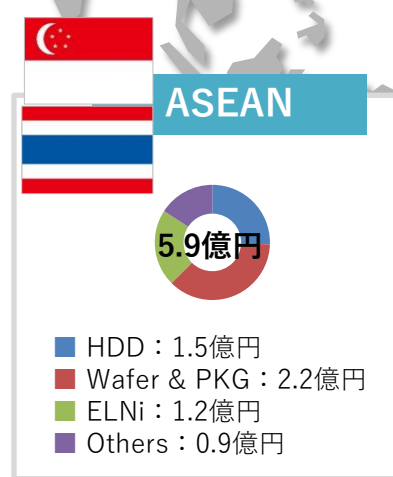
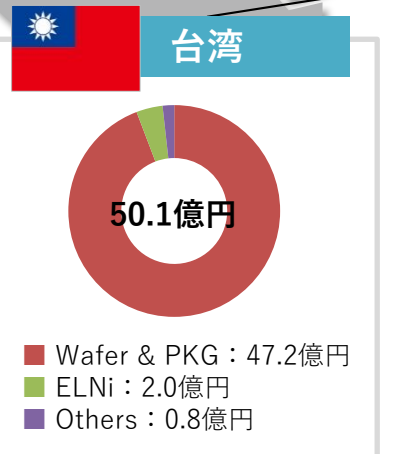
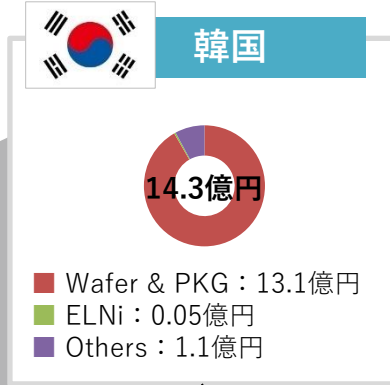
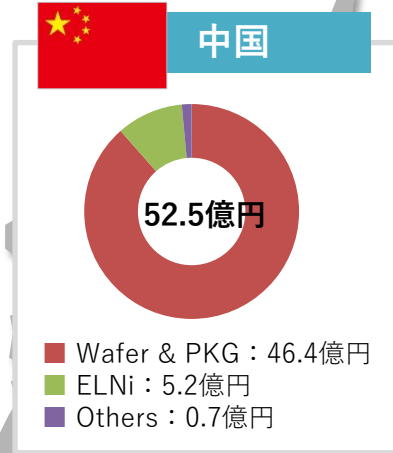
# 薬品ビジネス 最終製品までの流れ



# 地域別薬品売上高

2024年3月期 第2四半期累計

※内部売上高含む



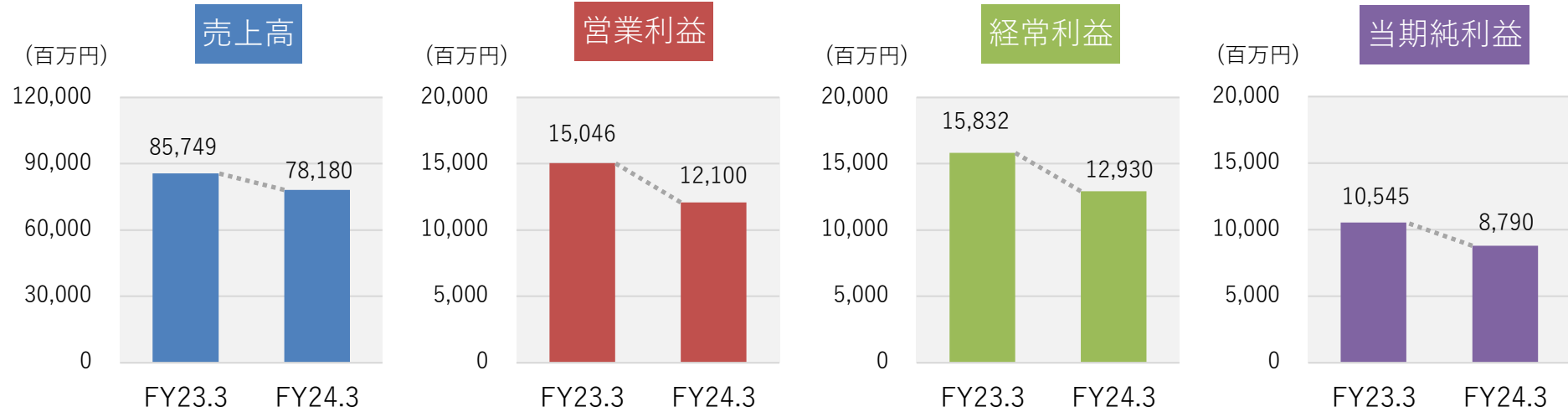
## 連結業績予想の修正

(単位：百万円)	前回発表予想	今回修正予想	増減額	増減率
売上高	66,230	78,180	+ 11,950	+ 18.0%
営業利益	10,230	12,100	+1,870	+18.3%
経常利益	10,360	12,930	+2,570	+24.8%
当期純利益	7,030	8,790	+1,760	+25.0%
1株当たり 当期純利益	424.54円	542.02円		

### 《修正の理由》

表面処理用機械事業において、車載用パワーデバイスの製造に使われる半導体ウェハー向けのめっき用装置の販売が好調に推移したほか、表面処理用資材事業では、車載用のIGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）向けのめっき薬品の販売が、EV, PHV, HV車の普及を受けて堅調に推移したことから、売上高、利益ともに前回発表予想を上回る見込みとなった。

# 2024年3月期 通期業績予想



(単位：百万円)	前期実績	当期予想 (2023.11.13修正)	増減額	増減率
売上高	85,749	78,180	△ 7,569	△ 8.8%
営業利益	15,046	12,100	△ 2,946	△ 19.6%
経常利益	15,832	12,930	△ 2,902	△ 18.3%
当期純利益	10,545	8,790	△ 1,755	△ 16.6%
為替：米ドル	131.62円	141.12円	9.50円安	

# 2024年3月期 通期業績予想

## ● 事業セグメント別売上高・営業利益予想

(単位：百万円)	売上高				営業利益			
	前期実績	当期予想 (2023.11.13修正)	当Q2 累計実績	対予想 進捗率	前期実績	当期予想 (2023.11.13修正)	当Q2 累計実績	対予想 進捗率
表面処理用資材	70,494	60,800	28,976	47.7%	13,887	10,950	4,966	45.4%
表面処理用機械	9,460	12,300	5,804	47.2%	941	1,310	771	58.9%
めっき加工	4,946	4,280	2,021	47.2%	△ 316	△ 470	△ 194	-
不動産賃貸	844	800	408	51.0%	514	310	251	81.2%

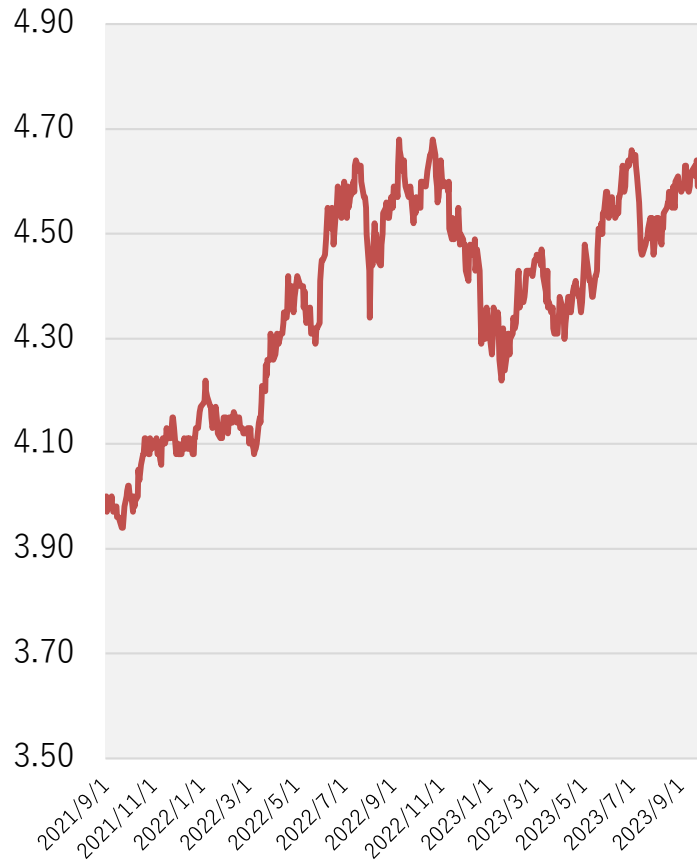
## ● 薬品カテゴリー別売上高予想

(単位：百万円)	前期実績	当期予想 (2023.11.13修正)	当Q2 累計実績	対予想 進捗率
HDD関連	2,329	1,600	818	51.2%
Wafer & PKG関連	39,198	33,310	16,586	49.8%
汎用無電解Ni関連	4,437	4,435	2,304	52.0%
薬品その他	4,141	3,080	1,372	44.6%
合計	50,107	42,425	21,082	49.7%



# 為替レートの推移

## ニュー台湾ドル



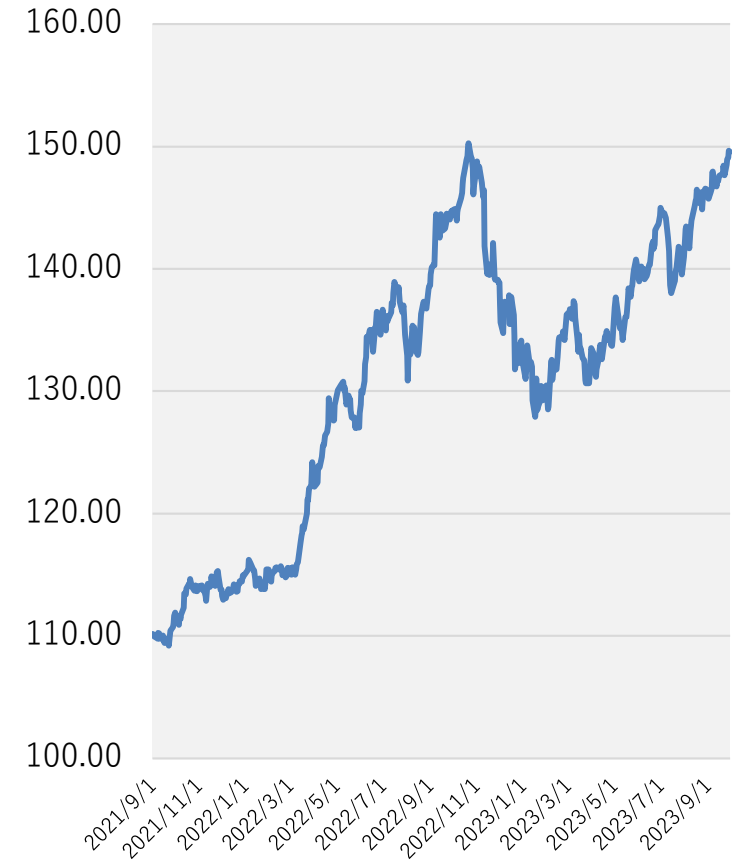
— ニュー台湾ドル

## 人民元



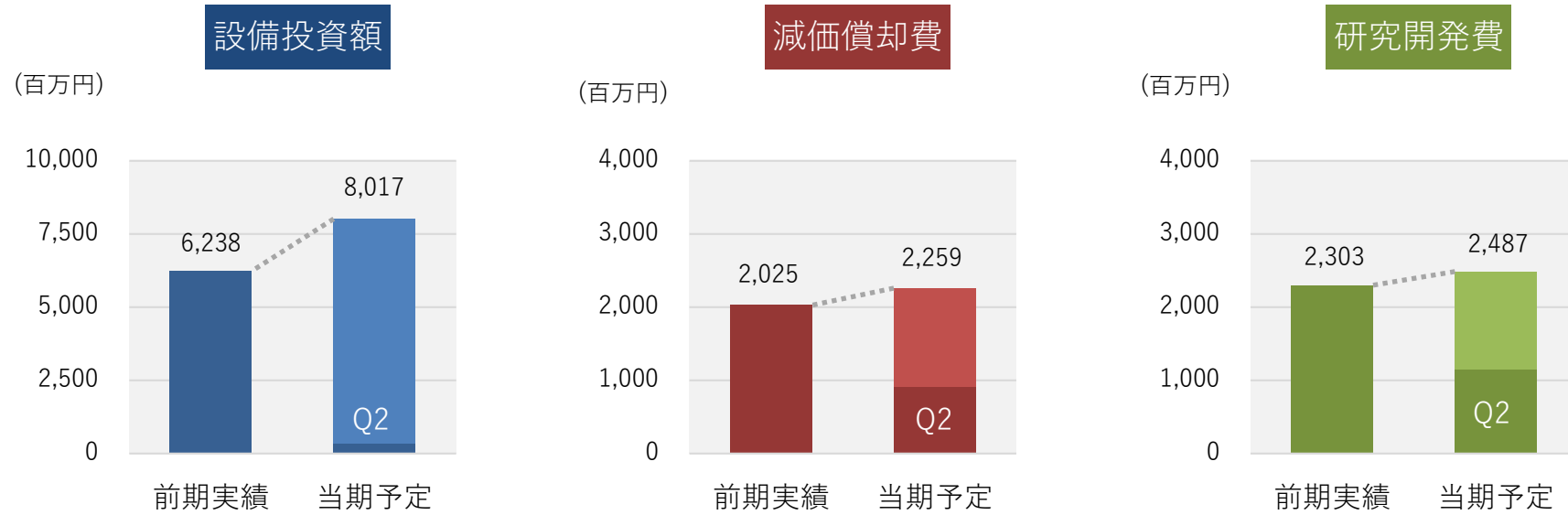
— 人民元

## 米ドル



— 米ドル

# 設備投資/減価償却/研究開発費



(単位：百万円)	前期実績 (通期)	当第2四半期 累計実績	当期予定 (通期)
設備投資額	6,238	358	8,017
減価償却費	2,025	923	2,259
研究開発費	2,303	1,153	2,487

# 資本政策

安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上を基本方針とした資本政策に取り組んでいます

連結総還元性向 50%、ROE 8.5%を目標

2022年3月期-2024年3月期の3年間で60億円規模の弾力的な自己株式取得を実施  
中長期的にはROE 10%を目指す

- ・ 総還元性向による安定した配当の実現と自己株式取得の機動的な実施
- ・ 経済状況、財務状況等を総合的に勘案した弾力的な自己株式取得の実施
- ・ 将来の成長が見込まれる分野や地域、新たな技術取得、M&A、想定外の事態や自然災害に備えた内部留保の確保

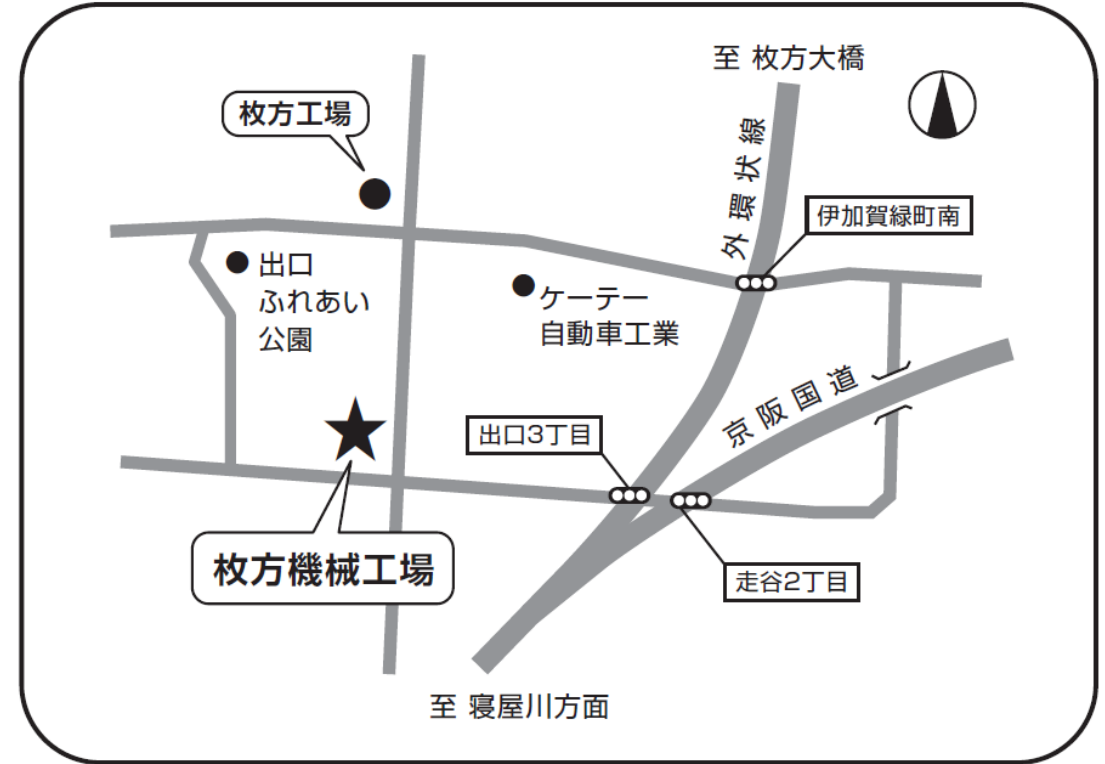
※当社は、役職員と共に持続的な企業価値創造を実現していくため、その動機付けの原資として、またM&A戦略（M&Aや業務資本提携等）を実施するため、その対価として一定の自己株式を保有します。

※M&A戦略を実施しなかった場合は、発行済株式総数の10%を超える部分については、消却いたします。

## <トピックス> 新機械工場（大阪府枚方市）竣工



- ・所在地：大阪府枚方市出口1-17-20
- ・敷地面積：約4,978m<sup>2</sup>
- ・総投資額：約39億円（土地・建物等）
- ・半導体用めっき装置の製造専用エリア保有
- ・SDGsやカーボンニュートラルに配慮した基本設計



**11月27日業務開始予定**

## <トピックス> 上海技術センター開設予定



- ・所在地：上海市化学工業区北河路17-10号厂房
- ・建物名：上海国際化工新材料科学技術革新  
センター科創基地 中試工場棟10号
- ・総投資額：約16,500千元（建物・分析機器等）
- ・クリーンルーム、実験室、分析室等完備

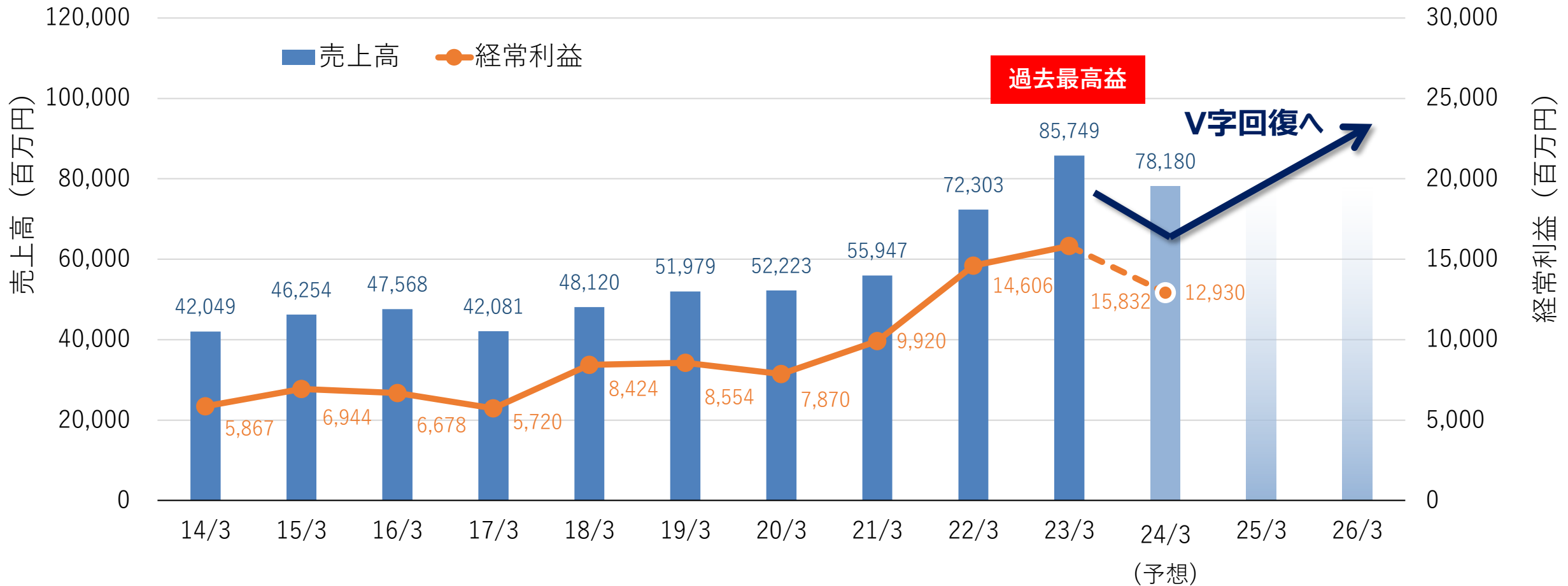
### 上海国際化工新材料创新中心（上海化学工業区）



**2024年4月業務開始予定**

# 2025年3月期以降の業績展望

2024年3月期は、主にパッケージ基板の生産調整の影響を受けて、過去最高益を達成した2023年3月期を下回る見通し。2025年3月期以降は、エレクトロニクス市場の回復により、V字回復を目指す。



# 主要ビジネス状況

---



## ➤ 現行市場状況

- ① 国内：PC関連はコロナ禍前に戻りつつあるが、未だサーバー関連は在庫調整により出荷が大きく減少した状態が継続。特にHDDに関しては、HDDの交換周期が**4年から5年**に延長され、記憶容量を**Max60%から80%**へアップされたため需要は伸びているものの、出荷数量は減少したままになっています  
パワーデバイスは落ち率は低く比較的堅調

- ② 海外：国内とほぼ同じ傾向。車載も同様

＊ 半導体関連は在庫調整が終われば潜在的に需要は戻ると予想



高密度パッケージ基板対応

小径ビアへの付きまわり向上低応力無電解銅めっき浴

半導体事業拡大

最先端半導体パッケージ用電解めっきプロセスの開発 (NEDO事業参加)

新規接合材料 (Ag焼結、Cu焼結) へ適したプロセスの開発

作業環境改善

密着向上剤によるデスミアフリープロセスに加え、ガラス上への金属酸化膜

形成プロセス(MOSL: Metal Oxide Seed Layer)の開発

レアメタル使用量低減

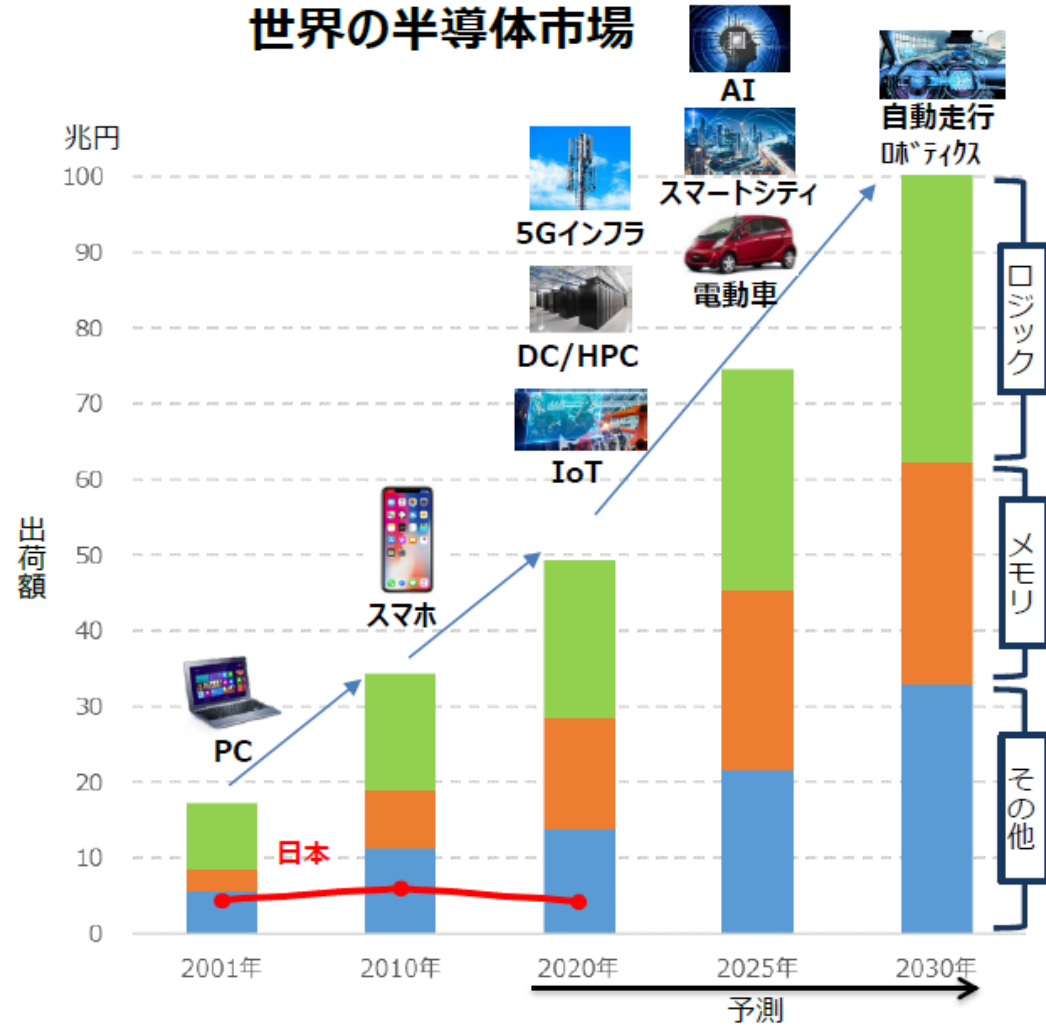
無電解銅めっき前処理プロセス酸洗添加剤による低濃度パラジウム触媒

環境負荷改善

電解銅めっき浴のリサイクルシステムによる廃液量低減

環境有害物質(フリーシアン, 鉛, ホルマリン等) を使用しないめっき浴

# 世界の半導体市場の動向

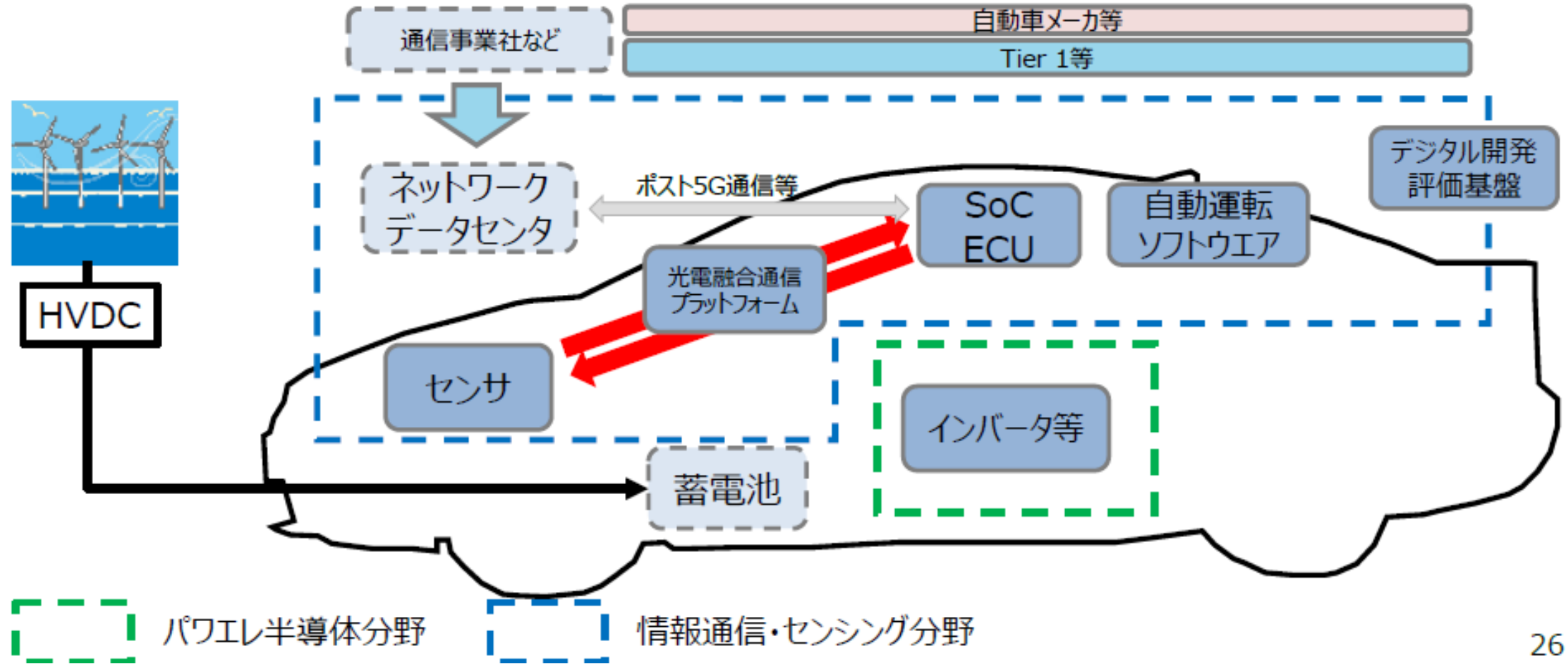


	市場規模 2018年	製品例	主要企業
ロジック (制御用)	21兆円	プロセッサ	intel tsmc
		GPU	QUALCOMM NVIDIA
		SoC	
メモリ (データ記憶用)	18兆円	DRAM	SAMSUNG SK hynix
		NAND	Micron KIOXIA
その他	15兆円	アナログLSI	Infineon SONY
		パワー半導体	ON Semiconductor
		イメージセンサ	MITSUBISHI ELECTRIC

(出典) Omdiaのデータを基に経済産業省作成 54

経済産業省：「半導体・デジタル産業戦略」まとめ(2021) 半導体戦略.PDF P54より

# 車載半導体の使用箇所



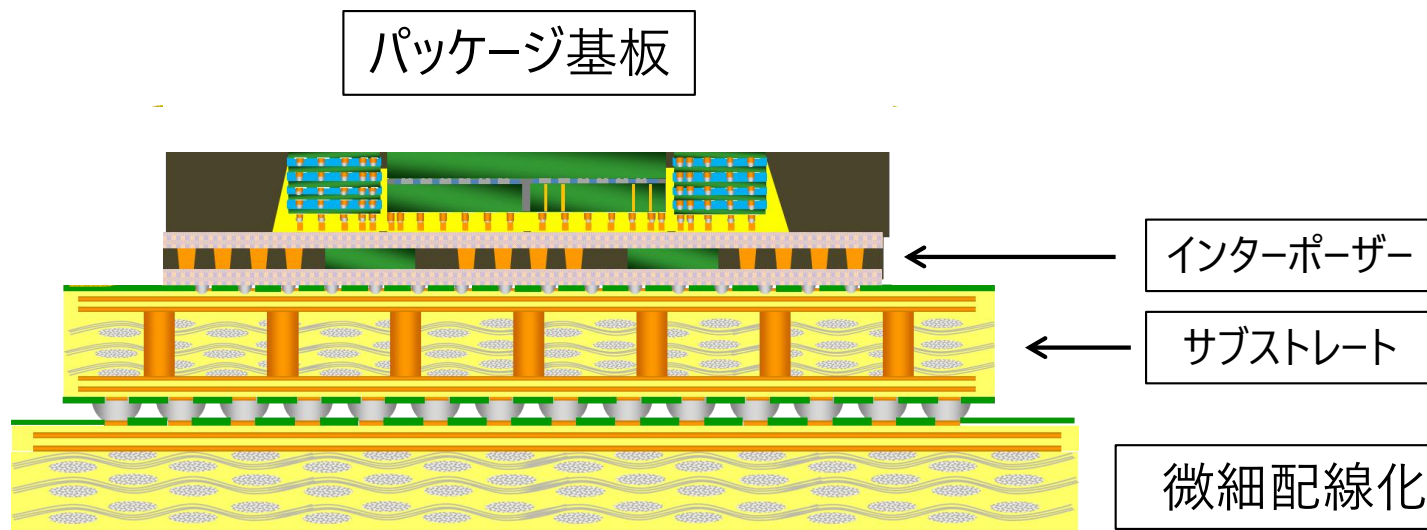
有機溶剤や過マンガン酸塩を有するデスミアプロセスを使用せず  
平滑で高密着な回路形成が可能となるプロセスを開発

## 3ステップ処理

- 1 紫外線照射
- 2 密着向上処理
- 3 熱処理

無電解銅 + 電解銅後SEM断面観察 ×5000			
従来	銅めっき皮膜		
	ABF樹脂		
デスミア フリー			
	GL102	GL103	GY50

# 次世代パッケージ基板内ガラスコアへのシード層形成



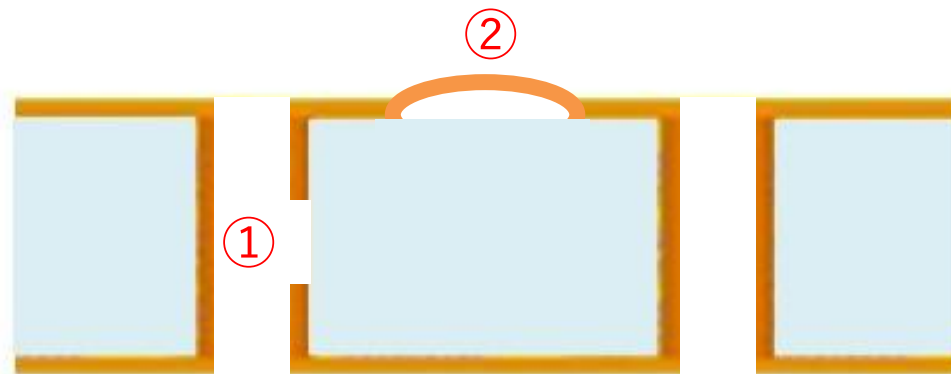
## ガラス特性

- 高剛性
- 低熱膨張係数
- 高平滑性

## 要求特性

- ⇒ ねじれ寸法精度
- ⇒ 反り寸法精度
- ⇒ 微細配線形成

微細配線化へインターポーザーやサブストレートにガラス採用



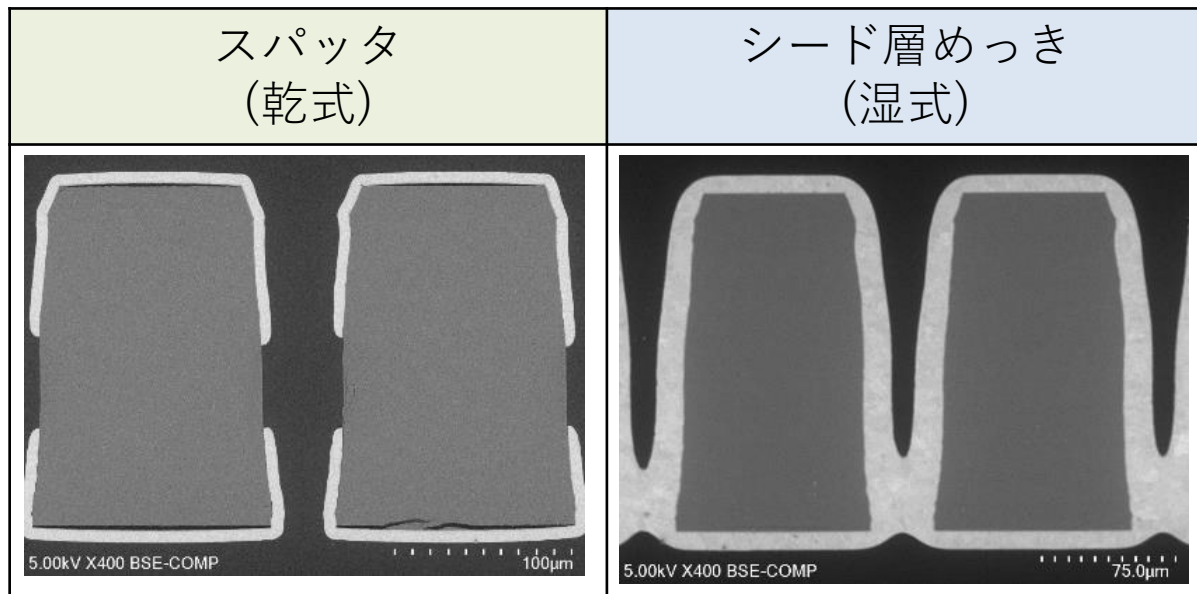
スルホール付きガラス基板

## 懸念事項

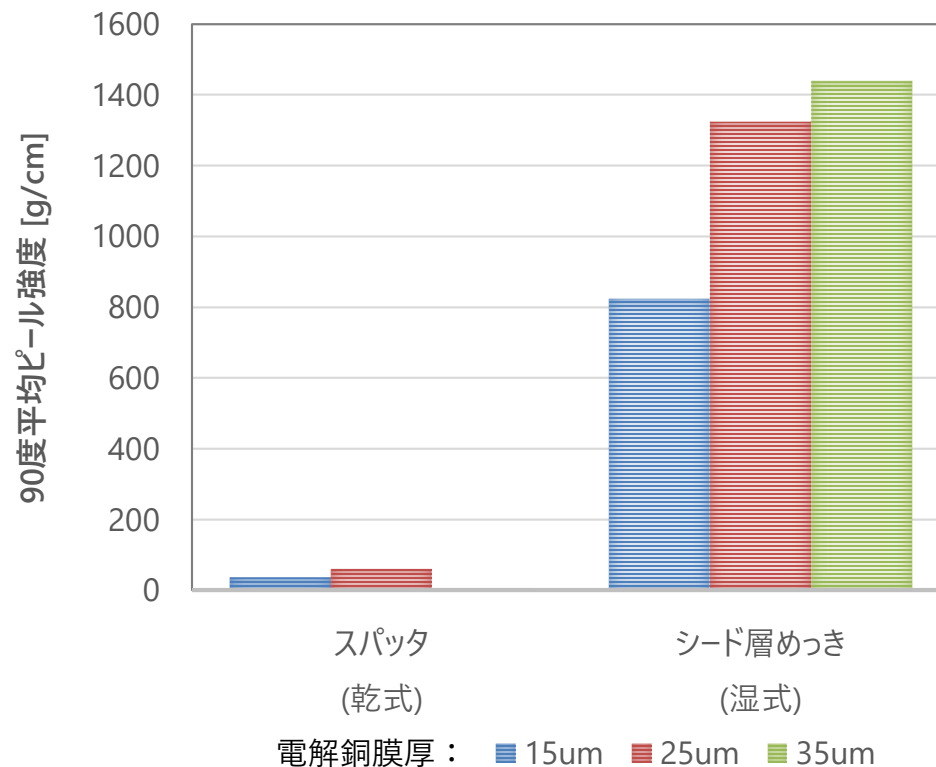
- ① スルホール内断線
- ② 配線密着性

# 次世代パッケージ基板内ガラスコアへのシード層形成

## スルホール内断線



## 配線密着性



シード層めっきは両者の懸念事項をクリアしている



熱処理温度

300

°C

低温度処理プロセス

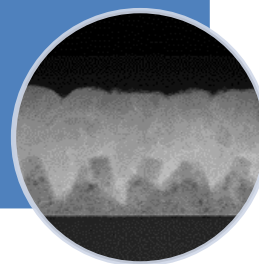


ピール強度：25um膜厚

1

kgf/cm

ガラスとの高密着性



アスペクト比：10

98

%

スルホール内

高めっき付きまわり



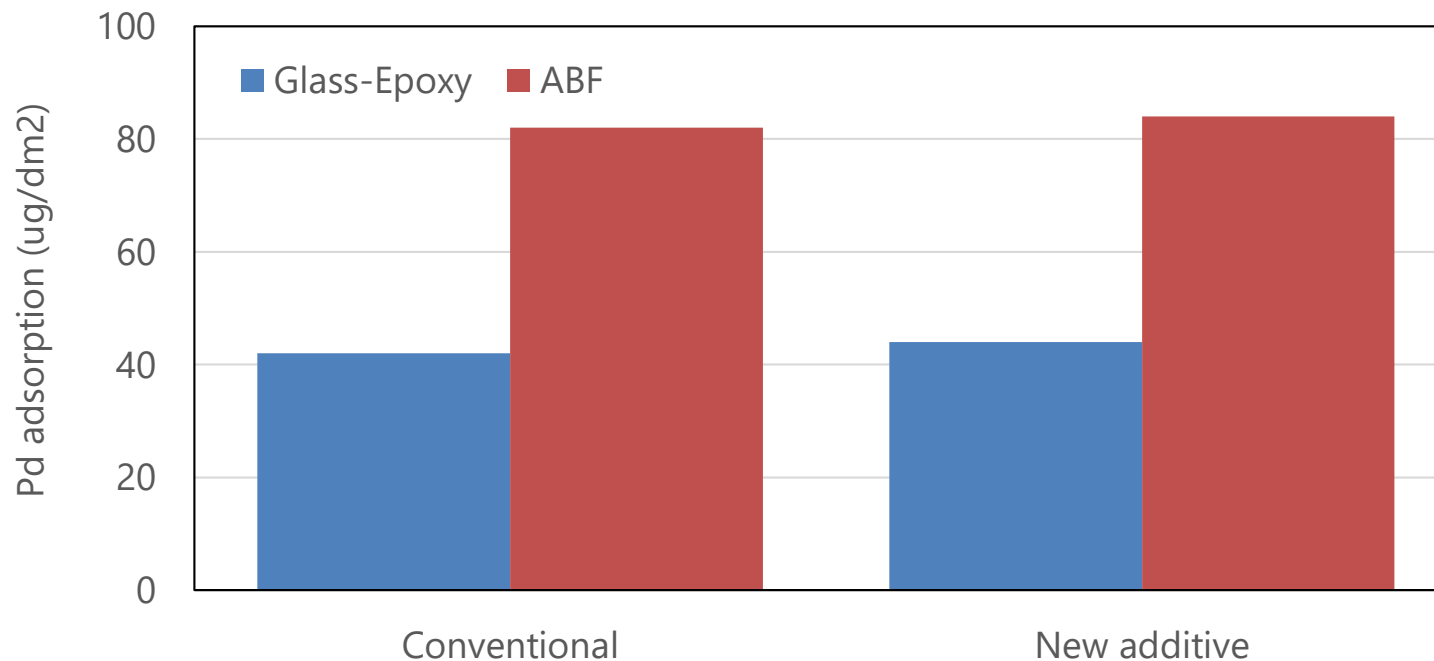
高密度化に対応する基材変化においてもめっきプロセスにて高性能で安価に基板製造が可能





アクチベーターの前の酸洗処理に添加剤を加えることにより

アクチベーター浴中のPd濃度を **200mg/L** ⇒ **50mg/L (75%削減)** にできるプロセスを開発

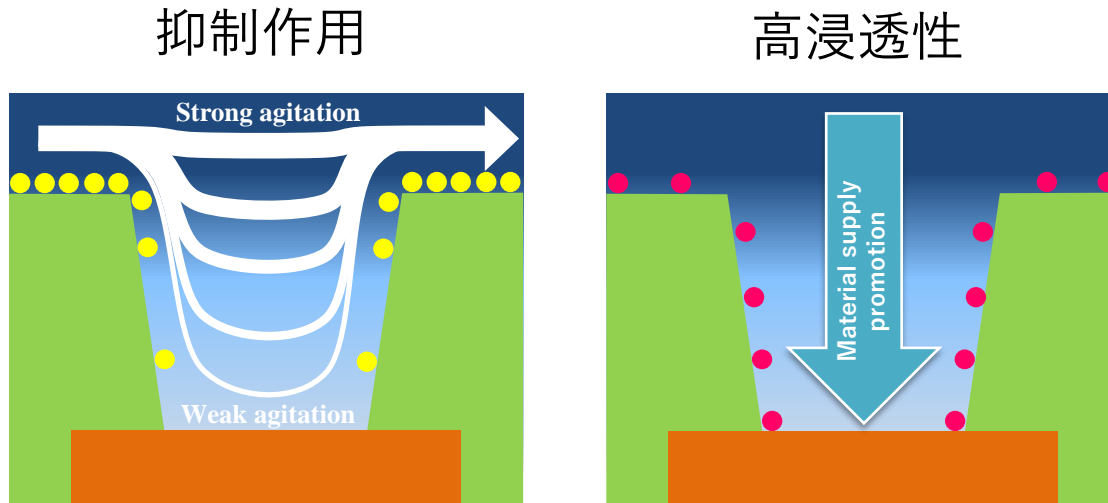


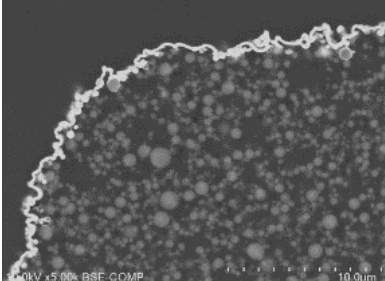
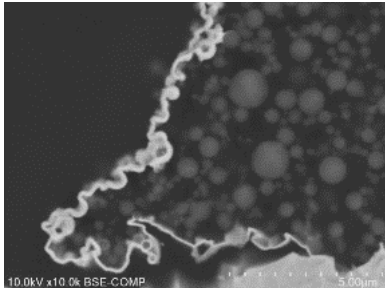
Pd濃度を減少させても、吸着量は変わらずめっき後の密着性や信頼性に問題はない



# 次世代パッケージ基板対応低応力無電解銅めっき浴

高密度パターン形成における0.2um以下のめっき膜厚にて、小径ビアへのめっき付きまわりが良好、かつ面内膜厚分布が良好な無電解銅めっき浴を開発



Thickness	30umΦ/35umh
Surface (x5,000)	0.199μm 
BVH Bottom (x10,000)	0.154μm 
Throwing power	77%

添加剤による抑制作用と高浸透性により小径ビアへの良好な付きまわりを実現

## JOINT2コンソーシアム



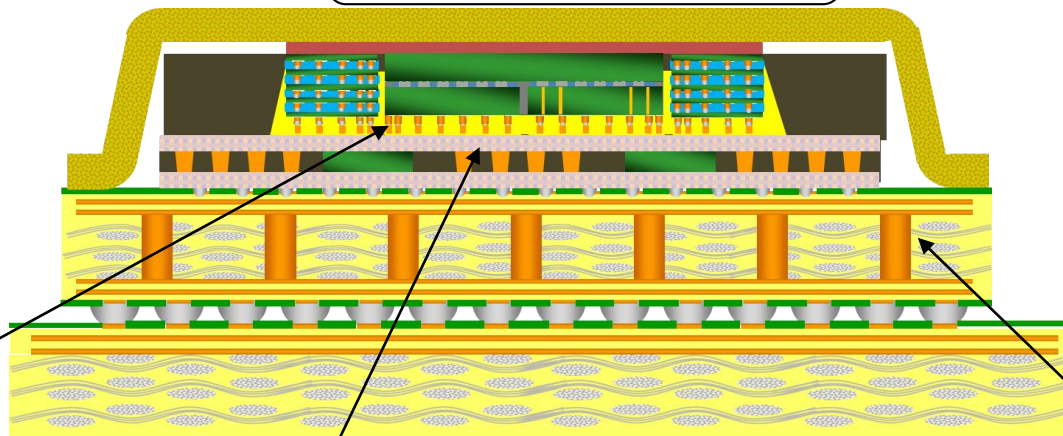
経済産業省ホームページ 内  
 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発  
 (助成)」採択結果一覧 20210531002-1.pdf より抜粋  
<https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210531002/20210531002.html>

ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業  
 研究開発項目②先端半導体製造技術の開発  
 採択結果一覧

No.	開発テーマ	実施体制(予定)
1	(b1) 高性能コンピューティング向け実装技術	<b>TSMCジャパン3DIC研究開発センター株式会社</b> (共同実施先、協力企業等) 国立研究開発法人産業技術総合研究所、イビデン株式会社、 多数の国内材料、製造装置メーカー、大学・研究機関(※企業・ 機関名は採択テーマ概要資料を参照)
2	(b2) エッジコンピューティング向け実装技術	<b>先端システム技術研究組合</b> (共同実施先、組合員企業等) 国立研究開発法人産業技術総合研究所、 株式会社SCREENホールディングス、ダイキン工業株式会社、富 士フイルム株式会社、パナソニックスマートファクトリリユーシ ョンズ株式会社、国立大学法人東京大学
3		<b>ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社</b>
4	(b3) 実装共通基盤技術	<b>昭和電工マテリアルズ株式会社</b> (共同実施先、協力企業等) 味の素ファインテクノ株式会社、 <b>上村工業株式会社</b> 、株式会社荏 原製作所、株式会社新川、新光電気工業株式会社、大日本印刷 株式会社、株式会社ディスコ、東京応化工業株式会社、TOWA株 式会社、ナミックス株式会社、パナソニックスマートファクトリーソ リューションズ株式会社、ヤマハロボティクスホールディングス株 式会社
5		<b>住友ベークライト株式会社</b>

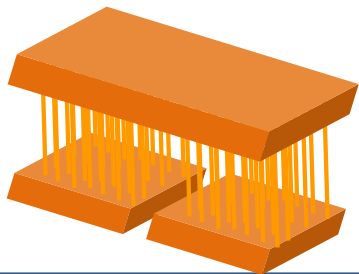
# JOINT2コンソーシアム技術目標

2.xD/3Dパッケージ



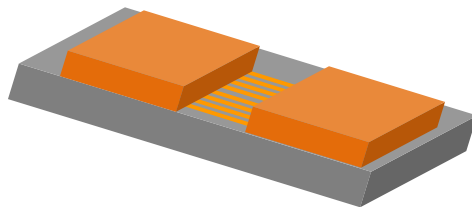
微細バンプ接合

Vertical interconnect



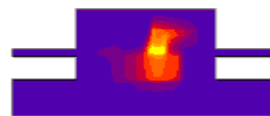
微細配線化技術

Lateral interconnect

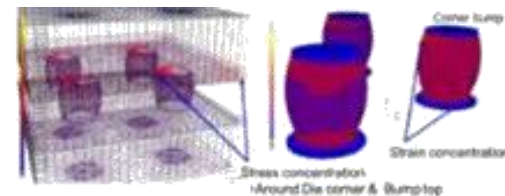


高信頼性パッケージ大型化

Thermal management



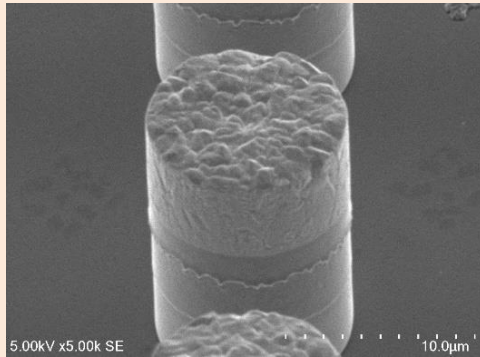
Stress management



# JOINT2コンソーシアムにおけるウエムラの役割

## 微細バンプ接合

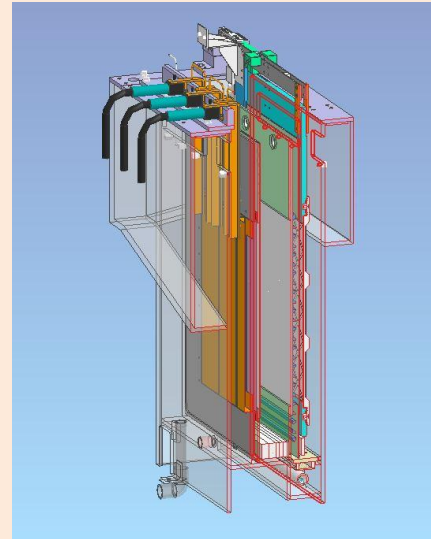
### 微細バンプ用 電解めっき液の開発



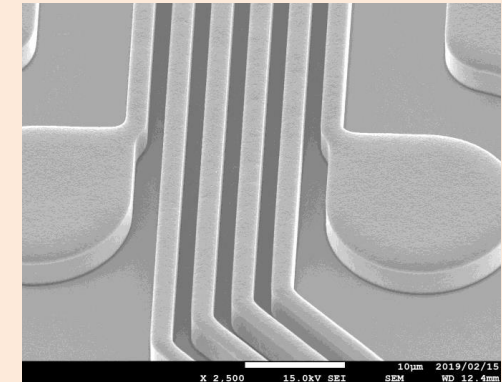
電解銅／ニッケル／錫-銀めっき  
(バンプ径：10μm)

## 微細配線化

### 次世代パッケージ用 電解めっき装置の開発



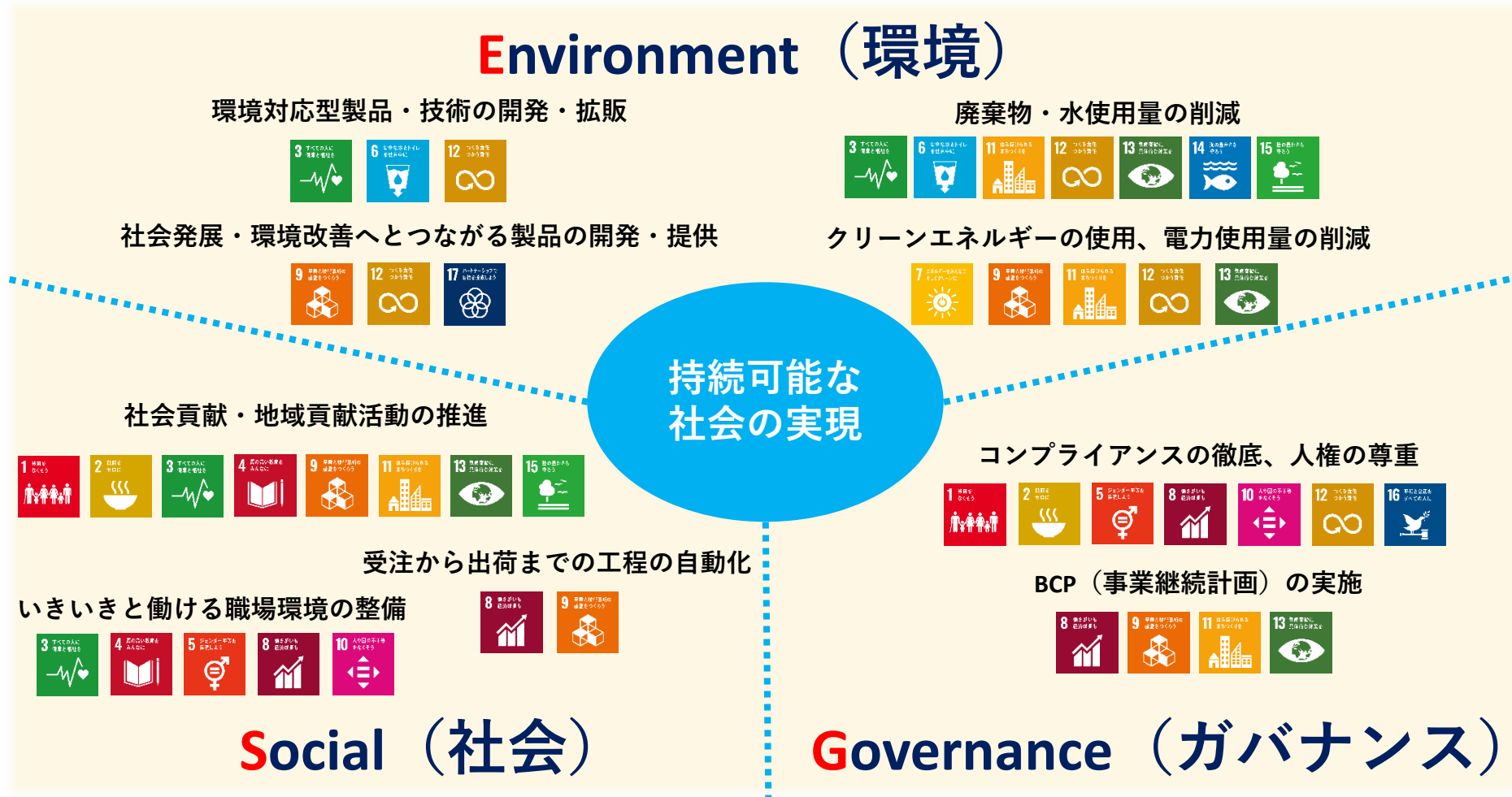
### 微細配線用 電解めっき液の開発



電解銅めっき  
(配線幅：2μm)

# ESG・SDGsに関する取り組み

当社は「Growing together with  (UYEMURA:You)」のグループ共通スローガンのもと、ステークホルダーの皆様と共に成長・発展し、社会に貢献できる企業を目指しています





# 環境対応製品 ～SDGsの積極的取り組み～

## 1. Pbフリーめっき浴

- ・無電解Niめっき浴。主に汎用浴向け。
- ・Pbフリーの電気Snめっき浴。純Sn、Sn-Ag浴など。電子部品向け。

## 2. シアンフリー浴

- ・シアンフリー & フリーシアン補給不要の無電解Auめっき浴。ウェハー、電子部品向け。

## 3. デスミアフリープロセス

- ・危険な過マンガン酸をつかわない基板向けプロセス。

## 4. ホルマリンフリー浴およびホルマリン不使用プロセス

- ・樹脂上へのダイレクトめっき（無電解Cu浴を使わない）。基板向け。
- ・ホルマリンフリー無電解Cu浴の開発。ウェハー向け。

## 5. PFOS, PFOAフリー浴

- ・PTFE複合めっき。主に車載部品向け。

## 6. 廃液処理

- ・めっき液リサイクルユニット



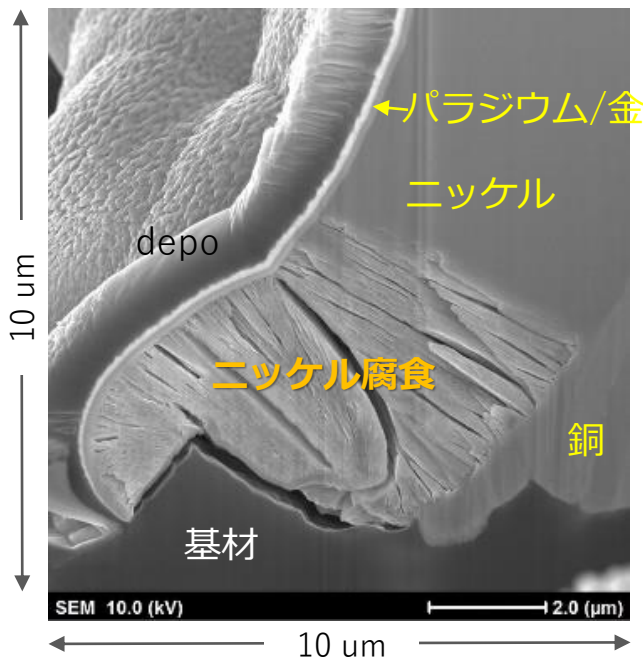
つくる責任、使う責任を果たす



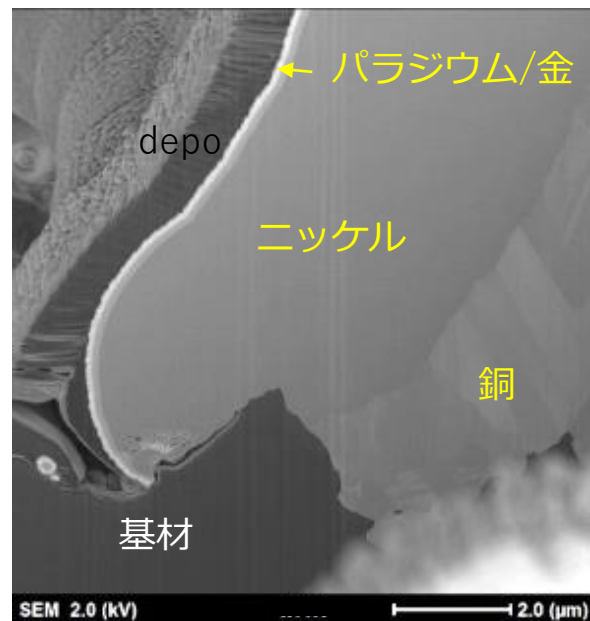


## Ni腐食の比較した断面観察

従来



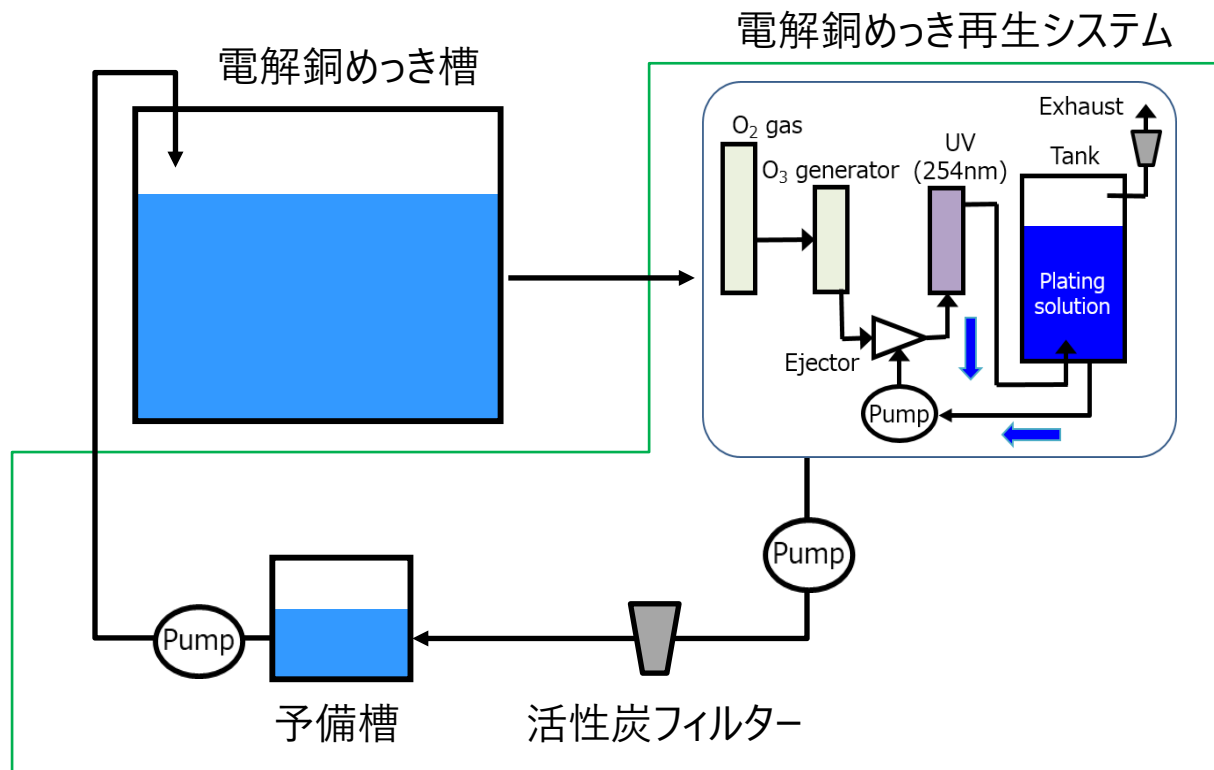
新規



貴金属めっきは一般的にフリーシアンを使用することで浴安定性や良好な皮膜性能を得ることが出来ます。主要な最終表面処理である無電解ニッケル/パラジウム/金工程において、フリーシアンを補給しない無電解金めっき液を用いると、下地のニッケル腐食を回避できませんでした。

→新規開発浴では、フリーシアンを補給することなく高品質なめっき皮膜を提供可能。

## 電解銅めっき 再生システムイメージ













電解銅めっき液は老化するに従い性能を阻害する不純物が蓄積するため、一定期間使用すると全量廃液→更新する必要があった。

この問題に対して「めっき液を部分的に再生システムで処理→めっき槽へ戻す」を繰り返しながら使用することで性能を一定に保ち理論上めっき液の寿命を半永久的に延ばすことが可能。



# グループ会社一覧

会社名	設立年	所在地	主な事業内容
上村工業株式会社	1848年(創業) 1933年(設立)	日本	    
株式会社サミックス	1963年	日本	
ウエムラ・インターナショナル・コーポレーション	1985年	米国	  
上村(香港)有限公司	1986年	中国 (香港)	
台湾上村股份有限公司	1987年	台湾	    
サムハイテックス	1987年	タイ	   
上村工業(深圳)有限公司	1988年	中国 (深圳)	   
ウエムラ・インターナショナル・シンガポール	1992年	シンガポール	
ウエムラ・マレーシア	1996年	マレーシア	 
上村化学(上海)有限公司	2002年	中国 (上海)	
韓国上村株式会社	2010年	韓国	 
ウエムラ・インドネシア	2012年	インドネシア	 



営業



研究開発



薬品製造



機械製造



めっき加工



不動産賃貸

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

# Growing together with



## Uyemura Group Companies

• Japan	C.Uyemura & Co., Ltd. Sumix Corporation	• Taiwan	Taiwan Uyemura Co., Ltd.
• USA	Uyemura International Corporation	• Korea	Uyemura Korea Co., Ltd.
• Hong Kong	Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd.	• Singapore	Uyemura International (Singapore) Pte Ltd
• Shenzhen	Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd.	• Malaysia	Uyemura (Malaysia) Sdn. Bhd.
• Shanghai	Uyemura (Shanghai) Co., Ltd.	• Thailand	Sum Hitechs Co., Ltd.
		• Indonesia	PT. Uyemura Indonesia